## NPN SILICON TRANSISTOR

# **HP122**

对应国外型号 TIP122

## 主要用途

#### 该器件为达林顿三极管内含阻尼二极管,用于高增益电路。

# 极限值(Ta=25)

T <sub>stg</sub> ——贮存温度55~150
T <sub>j</sub> ——结温
P <sub>C</sub> ——集电极功率耗散(T <sub>c</sub> =25 )65W
P <sub>C</sub> ——集电极功率耗散(T <sub>A</sub> =25 )2W
V <sub>CBO</sub> ——集电极—基极电压
V <sub>CEO</sub> ——集电极—发射极电压100V
V <sub>EBO</sub> ——发射极—基极电压5V
Ic——集电极电流5A

## 外形图及引脚排列



# 电参数(Ta=25)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
l <sub>CEO</sub>	集电极—发射极截止电流			0.2	mA	V <sub>CE</sub> =100V, I <sub>B</sub> =0
<b>I</b> CB0	集电极—基极截止电流			0.2	mA	V <sub>CB</sub> =100V, I <sub>E</sub> =0
<b>I</b> EBO	发射极—基极截止电流			2	mA	$V_{BE}=5V$ , $I_{C}=0$
$h_{\mathrm{FE}}$	直流电流增益	1000				$V_{CE}=3V$ , $I_{C}=0.5A$
$V_{\text{CE (sat)}}$	集电极—发射极饱和压降			2	V	$I_{C}=3A$ , $I_{B}=12mA$
				4.0	V	$I_{c}=5A$ , $I_{B}=20mA$
ВУсво	集电极—基极击穿电压	100			V	$I_{c}=1mA$ , $I_{E}=0$
BVCEO	集电极—发射极击穿电压	100			V	$I_{c}=5mA$ , $I_{B}=0$